



Импульсные диоды от ОАО «Цветотрон»

Представлены основные характеристики импульсных диодов 2Д695А, 2Д695Б, 2Д695В, а также 2Д814А, выпускаемых ОАО «Цветотрон».

Диод импульсный 2Д695А, 2Д695Б, 2Д695В (АЕЯР.432120.589 ТУ)

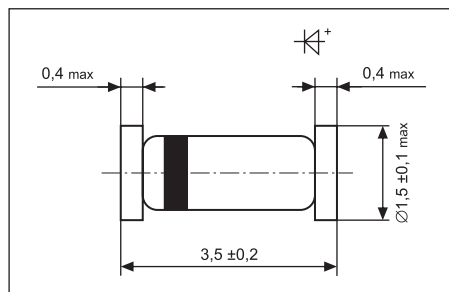


Рис. 1. Габаритный чертеж диодов 2Д695А, 2Д695Б, 2Д695В

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды 2Д695А, 2Д695Б, 2Д695В (рис. 1) в стеклянном корпусе КД-34 (ГОСТ 18472-88) предназначены для работы в аппаратуре специального назначения.

- Масса диода: не более 0,04 г.
- Диапазон рабочих температур: -60...+125 °С.
- Гарантийный срок: 25 лет.
- Гарантийная наработка: 80 000 ч.
- Цвет маркировки: красный.

Технические характеристики диодов представлены в таблице 1.

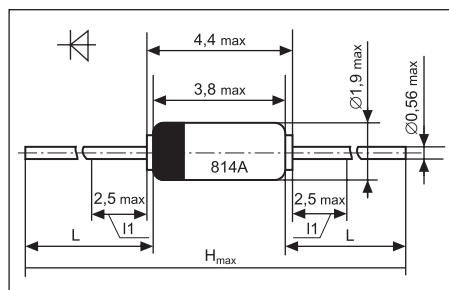


Рис. 2. Габаритный чертеж диода 2Д814А
I1 — неконтролируемая и непригодная для монтажа зона

Таблица 2. Габариты диодов

Обозначение	L, мм	H, мм
РИДП.432123.502	28,4 ± 0,2	60,8
РИДП.432123.501	28,7 ± 0,2	61,28

Таблица 1. Основные электрические параметры диодов 2Д695А, 2Д695Б, 2Д695В при T_{окр} = +25 °С

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра для диода					
		2Д695А		2Д695Б		2Д695В	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток, мкА	I _{обр}						
при U _{обр} = 200 В		—	0,1	—	—	—	—
при U _{обр} = 150 В		—	—	—	0,1	—	—
при U _{обр} = 100 В		—	—	—	—	—	0,1
Прямое напряжение, В при I _{пр} = 100 мА	U _{пр}	—	1	—	1	—	1
Обратное пробивное напряжение, В при I _{обр} = 100 мкА, t _p /T = 0,01, t _p = 0,03 мс	U _{проб}	250	—	200	—	120	—
Емкость, пФ при U _{обр} = 0 В и частоте сигнала f = 1 МГц	C _d	—	5	—	5	—	5
Заряд восстановления, нКл при переключении с I _{пр} = 30 мА на U _{обр} = 10 В	Q _{вос}	—	600	—	600	—	600
Время обратного восстановления, нс при I _{пр} = I _{обр} = 30 мА, i _{вос} = 0,1 × I _{обр} , R _с = 100 Ом	t _{вос.обр.}	—	50	—	50	—	50

Диод импульсный 2Д814А (АЕЯР.432120.340 ТУ)

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды 2Д814А (табл. 2, рис. 2) в корпусе КД-3 (ГОСТ 18472) предназначены для работы в аппаратуре специального назначения.

- Масса диода: не более 0,15 г.
- Диапазон рабочих температур: -60...+125 °С.
- Гарантийная наработка:
 - 80 000 ч в предельно допустимом режиме,
 - 120 000 ч в типовом режиме.

- Цвет маркировки: черный.

Основные технические характеристики диода 2Д814А приведены в таблице 3.

ОАО «Цветотрон»
(холдинг «ИНТЕГРАЛ»)

224022, Республика Беларусь,
г. Брест, ул. Карьерная, д. 11, корп. 3
Тел./факс: +375 (162) 48-68-14, 48-69-62
E-mail: postmaster@tvetotron.com,
cvetsbit@tut.by

Таблица 3. Основные электрические параметры диода 2Д814А при T_{окр} = +25 °С

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток при максимальном обратном напряжении, мкА	I _{обр}		
U _{обр1} = 75 В		—	5
U _{обр2} = 20 В		—	0,025
Прямое напряжение при постоянном токе I _{пр} = 10 мА, В	U _{пр}	—	1
Обратное пробивное напряжение при обратном токе I _{обр} = 100 мкА, В	U _{проб}	100	—
Емкость при обратном смещении U _{обр} = 0 В и частоте сигнала f = 1 МГц, пФ	C _d	—	4
Заряд восстановления при переключении с I _{пр} = 10 мА на U _{обр} = 10 В, нКл	Q _{вос}	—	200
Время обратного восстановления, нс при I _{пр} = 10 мА, U _{обр} = 10 В, i _{вос} = 0,1 × I _{обр} , R _с = 300 Ом	t _{вос.обр.}	—	4

Примечания.

1. I_{обр} при U_{обр2} = 20 В измеряется при T_{окр} = +(25 ± 5) °С
2. Время обратного восстановления (t_{вос.обр.}) гарантируется конструкцией и измерением заряда восстановления Q_{вос}.